強磁場マグネット応用を目指した次世代高温超伝導線材の電流輸送特性評価 Current Transport Properties of RE123 Coated Conductor for High Magnetic Field Applications

九大・シス情	井上 昌睦 , 東川 甲平 , Rene Fuger , 木須 隆暢
東北大・金研	淡路 智,難波 雅史,渡辺 和雄
超電導工研	福島 弘之,衣斐 顕,宮田 成紀,山田 穣,和泉 輝郎,塩原 融

M. Inoue¹, K. Higashikawa¹, R. Fuger¹, T. Kiss¹, S. Awaji², M. Namba², K. Watanabe², H. Fukushima³, A. Ibi³, S. Miyata³, Y. Yamada³, T. Izumi³, Y. Shiohara³

¹ Graduate School of ISEE, Kyushu University ² Institute for Materials Research, Tohoku University ³ Superconductivity Research Laboratory, ISTEC

1.はじめに

希土類系高温超伝導体を用いた次世代高温超伝 導線材の開発研究は,国内外で精力的に進められて おり,77K,自己磁場中での臨界電流 I。値が 153A である 1.3km 長の長尺線材[1]や、Ic=310A/cm-w の 500m 長線材[2]が得られるに至っている.近年,こ れらの次世代高温超伝導線材を用いた超伝導機器 の開発研究が始められており,国内では2008年度 より(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)のイットリウム系超電導電力機器技術開 発プログラム[3]にて,超電導電力貯蔵システム (SMES)や超電導電力ケーブル,超電導変圧器の 開発研究が実施されている.線材そのものの更なる 高性能化に向けた開発研究も進められており,特に 強磁場マグネット等の各種磁場応用機器開発にお いて重要となる磁場中 I。の向上は,重要な開発項目 の一つとして取り組まれている.磁場中 Leを向上さ せる方法としては,(1)希土類元素をイットリウ ムからガドリウム等の臨界温度が高いものに変更 する,もしくは希土類元素の混晶系を採用するもの と,(2)人工的なピンニングセンターを導入する ものとがあり,更にこれらを組み合わせたものも検 討されている[4-6]. 通常, これらの磁場中 I。特性向 上の有無は,液体窒素温度程度の比較的高い温度で 評価されており ,冷凍機冷却が可能な 20K 近傍を含 めた広範な温度領域に亘る評価はほとんど行われ ていない.

本研究では, GdBa₂Cu₃O₇₋₈ (GdBCO)に人工ピン

ニングセンターとして BaZrO3(BZO)を導入した高 温超伝導線材(以下 GdBCO+BZO線材と表す)の臨 界電流特性を,広い温度,磁場領域に亘って実験に より明らかとし,導入された人工ピンの効果につい て検討する.

2.実験

実験に用いた GdBCO+BZO 線材の構成は、下地か ら順に, Hastelloy(100µm) / Gd₂Zr₂O₇(0.8µm) / CeO₂(0.4µm) / GdBCO+BZO(1.2µm) / Ag(10µm)とな っており Gd₂Zr₂O₇層は Ion-Beam Assisted Deposition (IBAD)法で, CeO₂層および GdBCO+BZO 層は Pulsed Laser Deposition(PLD)法で作製されている. GdBCO内の BZOは, GdBCOにZrO₂を混入したタ ーゲットを用いることにより導入している.臨界電 流 *I*_cは, 1cm 幅の状態で約 250A/cm (77K, 自己磁 場)であった.

電流輸送特性の詳細な実験を行うため,線材を 1cm 長程度切り出した後,幅75µm,長さ500µmの マイクロブリッジ形状に加工し,実験用の試料とし た.加工方法はフォトリソグラフ法を用いたウェッ トエッチングである.

実験は,直流四端子法による電流-電圧測定を, 温度,磁場,磁場印加角度を系統的に変化させなが ら行った.温度は,液体ヘリウムの気化ガスの流量 および昇温用ヒータの出力を調整することにより 制御している.磁場は,17T以下の磁場領域には超 伝導マグネット(20T-SM)を,18T以上の磁場領域 にはハイブリッドマグネット(28T-HM)を用いて 印加しており,最大印加磁場は27Tである.磁場印 加角度は,試料ステージをステッピングモータで回 転させることにより変化させている.

3.実験結果および考察

Fig.1 に J。の磁場印加角度依存性を, Fig.2 に J。の 温度,磁場依存性を示す.導入した人工ピンの寄与 について考察するため,両図とも77K,自己磁場の J。にて規格化するとともに,人工ピンを導入してい ないGdBCO線材の臨界電流特性[7]を同一グラフ上 にプロットしている.Fig.1のJ。の角度依存性を見 てみると,膜面に垂直な磁場印加方向($\theta=90^\circ$, *B*//*c*-axis)のみならず,広い角度領域に亘ってJ。が 向上しており,全体としてJ。の異方性が小さくなっ ていることが分かる.また,条件によっては(例え









ば 65K の 1T や 5T) 垂直磁場の J_c が 平行磁場 θ =0°, *B*//*ab*-plane)の J_cよりも高くなっている .これより, *c* 軸方向に相間を有するピンニングセンターが効果 的に導入されていることが分かる . 20K においても 垂直磁場中の規格化 J_cは高くなっており,18T にて 77K,自己磁場の J_cと同程度の J_cが,27T の強磁場 中でも 77K,自己磁場中の J_cの 60%程度の J_cが得 られている.これらの結果は,人工ピンの導入に伴 う各種超伝導応用機器の最適設計の変化を検討す るうえで重要である.

J_c 値そのものを比較したのが, Fig.3 および Fig.4 である. Fig.3 に示す J_c の角度依存性について見て みると, GdBCO+BZO 線材の 77K, 自己磁場での J_c 値が 2.1×10¹⁰A/m² と,人工ピンを導入していない GdBCO 線材の J_c (=4.1×10¹⁰A/m²)の半分程度であ るため,低磁場領域においては全ての角度に亘って



GdBCO+BZO 線材の J。値が低くなっているが,磁場 の増加とともにその差は小さくなり,磁場の高い領 域では角度に対する最小の J。値は GdBCO+BZO 線 材の方が高くなっているが分かる.また,垂直磁場 での低温・強磁場特性(Fig.4)について着目すると, 20K,27T において 10¹⁰A/m²を超える J。が得られる ことが明らかとなった.現在,77K,自己磁場の J。 値が人工ピン導入前に比べて低いことから,人工ピ ン導入プロセスの最適化による更なる J。特性の向 上が期待される.

4.まとめ

本研究では,人工ピンとして GZO を導入した GdBCO線材の臨界電流特性を,広範な温度,磁場, 磁場印加角度領域に亘って実験により調べた.その 結果,幅広い角度領域に亘るピンニングの効果と, それに伴う異方性の改善が確認された.これらの結 果は,各種超伝導応用機器の最適設計が人工ピンの 導入に伴いどのように変化するかを検討する際の 基礎データとして重要である.

参考文献

- V. Selvamanickam et al., DOE High Temperature Superconductivity Program Peer Review (2008)
- [2] 小泉勉 他, 2008 年秋季低温工学・超電導学会 2A-a08
- [3]新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p08016.html
- [4] S.H. Wee et al., Supercond. Sci. & Tech. 21 (2008) 092001
- [5] M. Inoue et al., Physica C 463 (2007) 674
- [6] M. Miura et al., Appl. Phy. Express (2008) 051701
- [7] 井上昌睦他,東北大学金属材料研究所強磁場超 伝導材料研究センター平成19年度年次報告
 (2008) 24